

Dispositivo de silicio para la detección de radiación infrarroja a temperatura ambiente

Información de contacto

Dirección: Principales:

- JAVIER OLEA ARIZA

j.olea@upm.es

- ANTONIO MARTI VEGA

antonio.marti@upm.es

- ANTONIO LUQUE LOPEZ

a.luque@upm.es

Otros inventores:

- JavierOlea Ariza

Comparte autoría entre la UPM y la UCM

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

- GermánGonzález Díaz Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- DavidPastor Pastor Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- EricGarcía Hemme Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- IgnacioMártíl de la Plaza Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- RodrigoGarcía Hernansanz Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- Álvaro del Prado Millán Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- PabloFernández Sáez Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- RosaCimas Cuevas Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Tipo de oferta tecnológica

[Patentes](#)

¿Dónde?

[Instituto de Energía Solar \(IES\) Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares](#)

Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=899&id_archivo=5113&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

Descripción de la patente

Dispositivo de silicio para la detección de radiación visible e infrarroja a temperatura ambiente. La presente invención se refiere a un dispositivo con tres capas: dos semiconductores, (1) y (2), y una capa intermedia (3) aislante que están basadas en silicio cristalino. La implantación de impurezas con una concentración que supera la solubilidad sólida de dicha impureza en silicio confiere al dispositivo la

capacidad de detectar radiación infrarroja a temperatura ambiente. La invención también se refiere al método para fabricar el dispositivo de la invención, que incluye técnicas de fabricación fuera del equilibrio termodinámico.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P201400241

Número de publicación

ES2546917

Fecha de presentación

27/03/2014

Fecha de concesión

01/02/2016